

2SK619

シリコン N チャンネル MOS FET

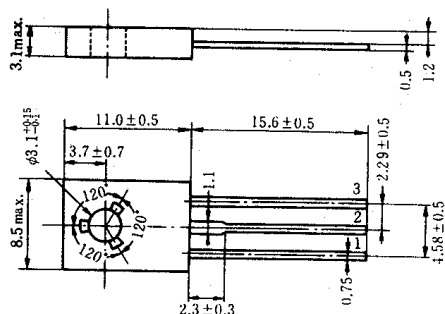
高周波増幅用

高インピーダンス増幅用

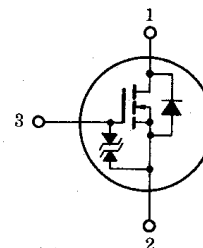
SILICON N-CHANNEL MOS FET

HIGH FREQUENCY AMPLIFIER

HIGH IMPEDANCE AMPLIFIER



1. ドレイン : Drain
 2. ソース : Source
 3. ゲート : Gate
- (Dimensions in mm)



(JEDEC TO-126 MOD.)

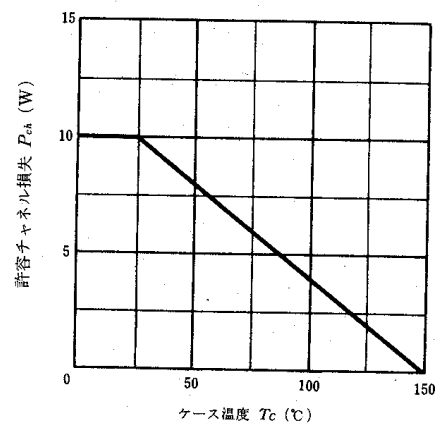
■絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項 目	Symbol	2SK619	Unit
ドレイン・ソース電圧	V_{DS}	70	V
ゲート・ソース電圧	V_{GS}	± 9	V
ドレイン電流	I_D	0.3	A
せん頭ドレイン電流	$I_{D(\text{peak})}$	0.5	A
許容チャネル損失	P_{ch}	1.0	W
	P_{ch}^*	10	W
チャネル温度	T_{ch}	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	$-55 \sim +150$	$^\circ\text{C}$

* $T_c=25^\circ\text{C}$ における許容値

* Value at $T_c=25^\circ\text{C}$

許容チャネル損失のケース温度による変化 MAXIMUM CHANNEL DISSIPATION CURVE



■電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項 目	Symbol	Test Condition	min.	typ.	max.	Unit
ドレイン・ソース破壊電圧	$V_{(BR)DS}$	$I_D=1\text{mA}$, $V_{GS}=0$	70	—	—	V
ゲート・ソース破壊電圧	$V_{(BR)GS}$	$I_D=\pm 1\text{mA}$, $V_{DS}=0$	± 9	—	—	V
ドレイン電流	I_{DS}	$V_{DS}=50\text{V}$, $V_{GS}=0$	—	—	1	mA
ゲート・ソース遮断電圧	$V_{GS(\text{off})}$	$I_D=1\text{mA}$, $V_{DS}=20\text{V}$	0.3	—	1.8	V
ドレイン・ソース飽和電圧	$V_{DS(\text{on})}$	$I_D=0.1\text{A}$, $V_{GS}=9\text{V}^*$	—	—	5.0	V
順伝達アドミタンス	$ y_{fs} $	$I_D=0.2\text{A}$, $V_{DS}=10\text{V}^*$	90	130	—	mS
入力容量	C_{iss}	$V_{DS}=10\text{V}$, $V_{GS}=0$, $f=1\text{MHz}$	—	10	—	pF
出力容量	C_{oss}		—	6	10	pF

* パルス測定

* Pulse Test